







	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> IPB80P04P407ATMA1</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH TO263-3</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IPB80P04P407ATMA1.pdf</a></p>
	<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p>
	<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	IPB80P04P407ATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET P-CH TO263-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 150µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-3-2
Serie	Automotive, AEC-Q101, OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	7.4 mOhm @ 80A, 10V
Verlustleistung (max)	88W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	6085pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	89nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	80A (Tc)

IPB80P04P407ATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB80P04P407ATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB80P04P407ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IPB80P04P407ATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IPB80P04P4L06ATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET P-CH TO263-3</p>	 <p><b>IPB80P03P4L-07</b> VB VB PG-TO263-3-2</p>	 <p><b>IPB80P03P4L07ATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET P-CH 30V 80A TO263-3</p>	 <p><b>IPB80R290C3A</b> INF IPB80R290C3A INF</p>
 <p><b>IPB80P04P4L-08</b> INFINEON IPB80P04P4L-08 INFINEON</p>	 <p><b>IPB80P04P4L08ATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET P-CH TO263-3</p>	 <p><b>IPB80P04P4L04ATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET P-CH TO263-3</p>	 <p><b>IPB80P04P405ATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET P-CH TO263-3</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPB80P04P407ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPB80P04P407ATMA1 Datenblatt	IPB80P04P407ATMA1-Datenblätter	IPB80P04P407ATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPB80P04P407ATMA1
IPB80P04P407ATMA1 Electronic	IPB80P04P407ATMA1-Komponenten	IPB80P04P407ATMA1-Verteiler	IPB80P04P407ATMA1-Bild	IPB80P04P407ATMA1-Teil
IPB80P04P407ATMA1 Preis	IPB80P04P407ATMA1 Hersteller	IPB80P04P407ATMA1 Bild	IPB80P04P407ATMA1 Aktie	IPB80P04P407ATMA1 Inventar
IPB80P04P407ATMA1 Neu	IPB80P04P407ATMA1 Original	IPB80P04P407ATMA1 garantiert	IPB80P04P407ATMA1 RFQ	IPB80P04P407ATMA1 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited